

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

E. Compound Semiconductors 분과

Room F

죽실 (본관, 5층)

2013년 2월 6일(수) 09:40-10:55

[WF1-E] Compound Semiconductor IV

좌장: 문재경(한국전자통신연구원)

- | | | |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WF1-E-1 | 09:40-10:10 | [초청] Comparison of Junctionless GaN FinFET and AlGaIn/GaN FinFET
Jung-Hee Lee ¹ , Ki-Sik Im ¹ , Jae-Hoon Lee ² , and Sorin Cristoloveanu ³
¹ School of Electrical Engineering and Computer Science, Kyungpook National University, ² GaN Power Research Group, Samsung LED Co., Ltd., ³ IMEP-LAHC |
| WF1-E-2 | 10:10-10:25 | AlGaIn/GaN/AlGaIn Double-Heterostructure를 이용한 FET의 누설전류 감소에 대한 연구
김준호, 황의진, 조성무, 조영제, 김광중, 장태훈
LG전자 Sytem IC 연구소 IGBT part |
| WF1-E-3 | 10:25-10:40 | Al의 열산화 방법을 이용한 AlGaIn/GaN 구조의 표면 Al₂O₃ 패시베이션 특성
김정진 ^{1,2} , 안호균 ¹ , 배성범 ¹ , 박영락 ¹ , 임종원 ¹ , 문재경 ¹ , 고상춘 ¹ , 남은수 ¹ , 양전욱 ²
¹ 한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부, ² 전북대학교 반도체화학공학부 |
| WF1-E-4 | 10:40-10:55 | 상시불통형 AlGaIn/GaN-on-Si MOSHFET
박봉렬 ¹ , 이재길 ¹ , 서광석 ² , 차호영 ¹
¹ 홍익대학교 전자전기공학부, ² 서울대학교 전기공학부 |